2SC1173

シリコンNPNエピタキシアル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS

○ 電力増幅用

○ カーラジオ，カーステレオ出力段に適しています。

o Power Amplifier Applications

o Output Stage Application of Car Radio and Stereo

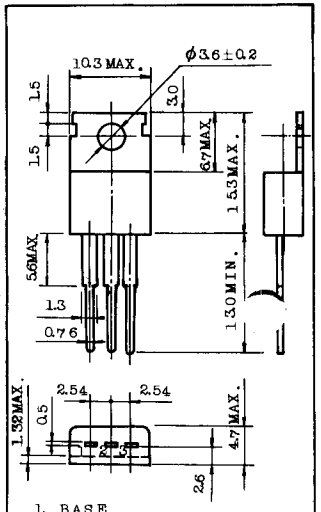
・ 電流増幅率の直線性がよい。

・ 2SA473のコンプリメンタリで出力5Wが得られます。

・ Good Lineality of h_{FE}

・ Complementary to 2SA473 and 5 Watts Output Application

Unit in mm



JEDEC	TO-220AB
EIAJ	SC-46
TOSHIBA	2-10A1A

アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT No. AC75

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	30	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	3	A
エミッタ電流	I_E	−3	A
コレクタ損失 (T_C=25°C)	P_C	10	W
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	−55～150	°C

※PCT技術により製造されています。
Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

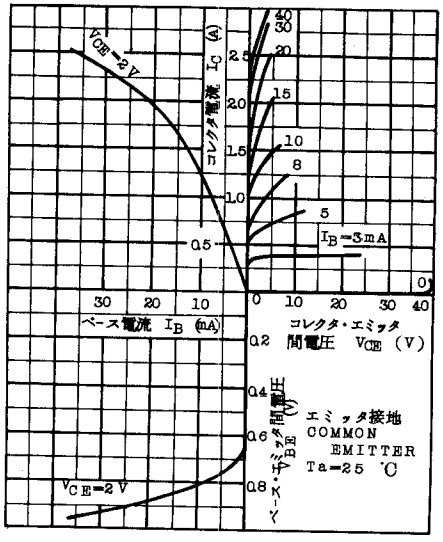
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20V$, $I_E=0$	—	—	1.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V$, $I_C=0$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10mA$, $I_B=0$	30	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1mA$, $I_C=0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE}=2V$, $I_C=0.5A$	70	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2V$, $I_C=2.5A$	25	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2A$, $I_B=0.2A$	—	0.3	0.8	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=2V$, $I_C=0.5A$	—	0.75	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=2V$, $I_E=-0.5A$	—	100	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V$, $I_E=0$, $f=1MHz$	—	35	—	pF

Note; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し，現品表示してあります。

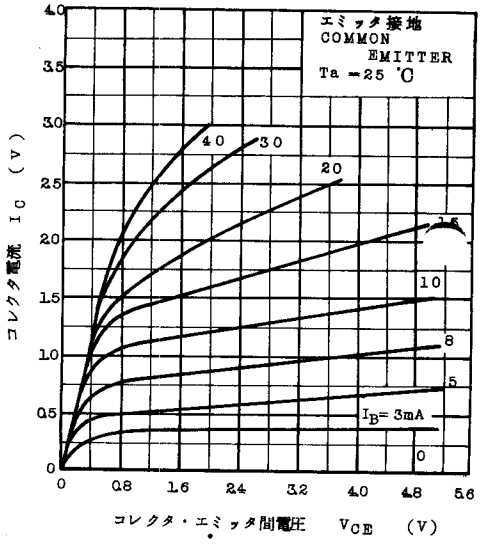
According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SC1173 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC1173-O	70	140
2SC1173-Y	120	240

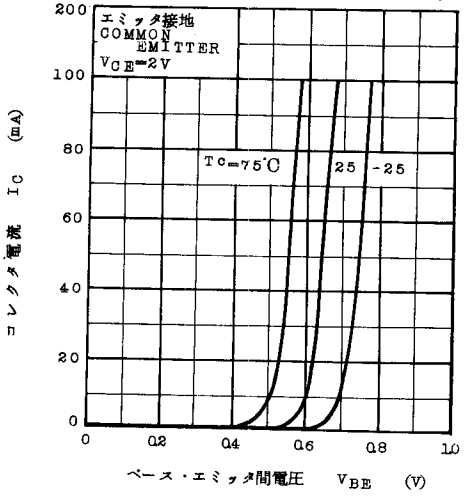
STATIC CHARACTERISTICS



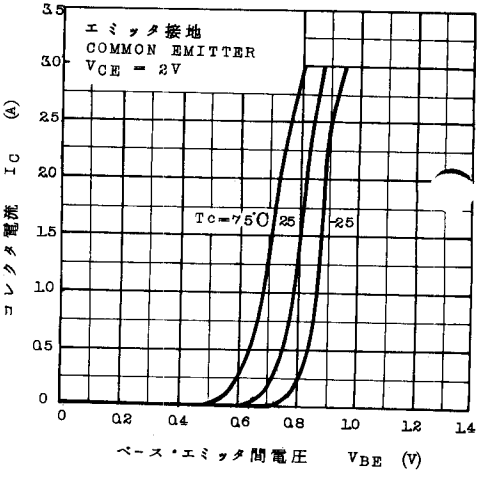
I_C - V_{CE} (LOW VOLTAGE REGION)



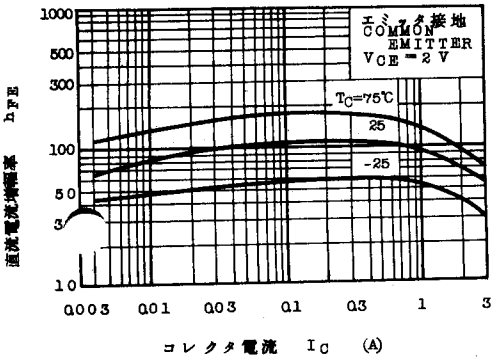
I_C - V_{BE} (LOW CURRENT REGION)



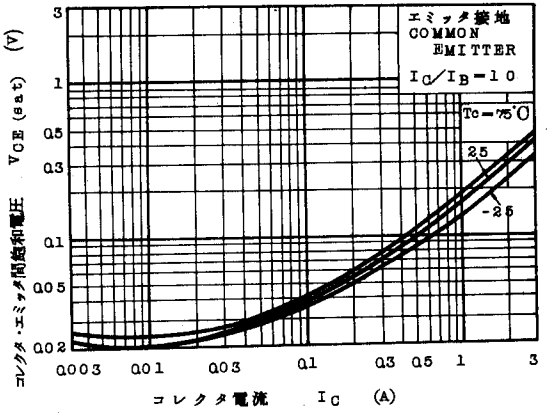
I_C — V_{BE}



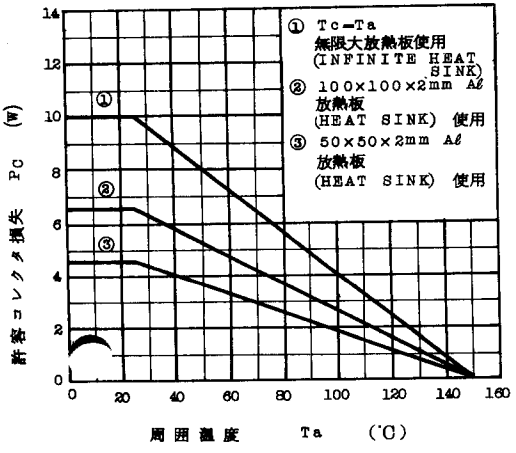
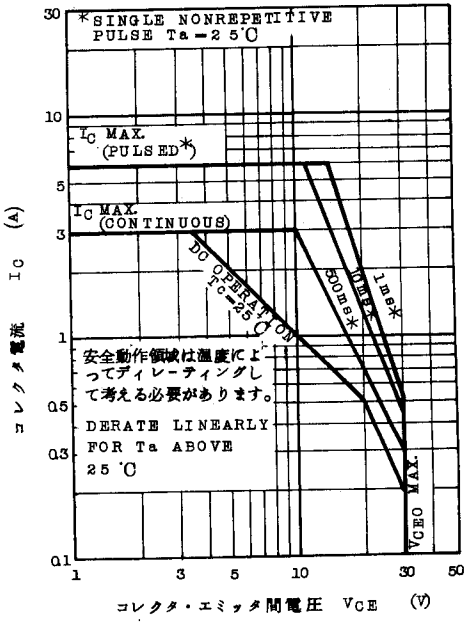
hFE - IC



VCE(sat)-IC



PC - Ta



安全動作領域 ASO